

高性能多模式PWM控制芯片

概述

AP8268是一款高集成度的电流模式PWM控制芯片，具有高性能、低待机功耗、低成本等特点。AP8268通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术，实现了低待机功耗和全电压范围内的最佳效率，频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。AP8268同时提供了全面的管脚开短路保护，以及逐周期过流保护、VDD过压保护、欠压锁存、过温保护、输出过压保护、过载保护、输出二极管短路保护等功能。

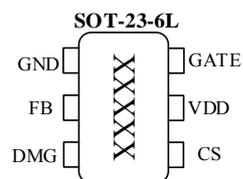
产品特征

- 软启动功能
- QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode混合模式提高效率
- 专利的频率抖动技术提高EMI性能
- 内部集成斜率补偿功能
- 高低压分频功能
- 自适应的线电压补偿功能
- 全面的保护功能包括
 - ◇ 过温保护 (OTP)
 - ◇ 输出过压保护
 - ◇ 逐周期过流保护 (OCP)
 - ◇ 输出开/短路保护
 - ◇ 专利的DMG电阻开/短路保护
 - ◇ 次级整流管短路保护
 - ◇ 过载保护 (OLP)

应用领域

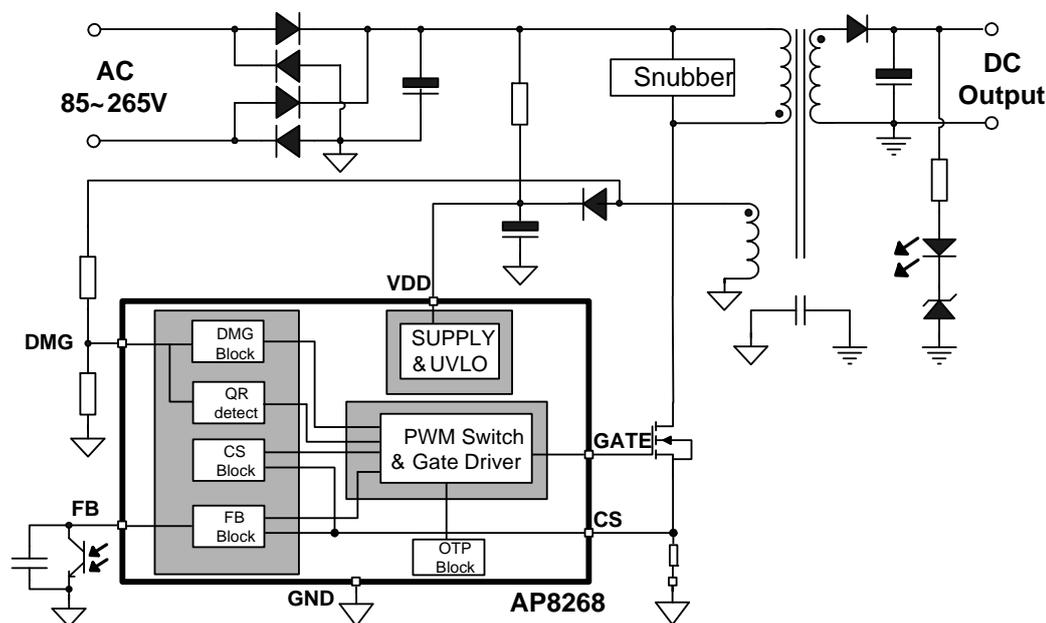
- 待机电源
- 开放式开关电源
- 适配器

封装/订购信息



订购代码	封装	版本差异
AP8268ATCC-R1	SOT-23-6L	带QR功能
AP8268BTCC-R1	SOT-23-6L	不带QR功能

典型应用



极限工作范围

VDD 脚耐压.....	-0.3~45V	管脚焊接温度（10秒）.....	260℃
DMG 脚耐压(IDMG≤10mA).....	-1~7V	封装热阻 θ_{JA} （SOT-23-6L）.....	200℃/W
FB, CS 脚耐压.....	-0.3~7V	人体模式 ESD 能力 ⁽¹⁾ (HBM).....	±4kV
GATE 脚耐压.....	-0.3~15V	机器模式 ESD 能力 ⁽²⁾ (MM).....	300V
存储温度范围.....	-55~150℃		

备注：1. 产品委托第三方严格按照芯片级ESD标准(JEDEC JDS-001-2014)中的测试方式和流程进行测试。

2. 产品委托第三方严格按照芯片级ESD标准(JESD22-A115C-2010)中的测试方式和流程进行测试。

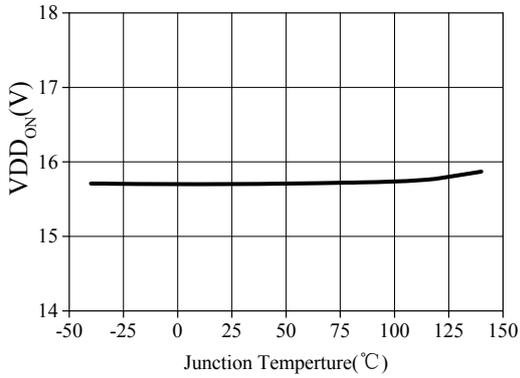
电气特性

($T_A = 25^\circ\text{C}$, VDD=15V, 除非另有说明)

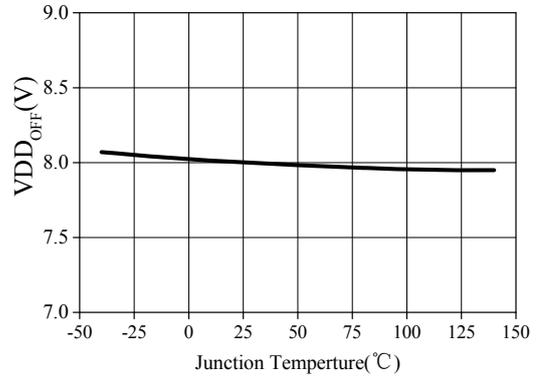
参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD电压部分						
VDD启动阈值电压	VDD _{ON}		15.0	15.7	17.0	V
VDD欠压保护阈值电压	VDD _{OFF}		7.0	8.0	9.0	V
VDD过压保护电压	V _{OV} P		37.0	40.5	43.0	V
上拉 PMOS 开启时 VDD 电压	V _{pull-up}			10.0		V
VDD电流部分						
启动态电流	I _{VDD_ST}	VDD=VDD _{ON} -1V		7.0	10.0	uA
开关态工作电流	I _{VDD0}	VFB=3.0V,CS=0.3V	1.0	2.2	3.5	mA
间歇态工作电流	I _{VDD1}	VFB=0.5V,CS=0.3V	0.4	0.5	1.0	mA
保护态工作电流	I _{VDD_Fault}		0.2	0.5	1.5	mA
震荡器部分						
开关频率	F _{OSC}	IDMG>330uA	60.0	65.0	70.0	kHz
		IDMG<330uA	80.0	90.0	100.0	kHz
间歇态工作频率	F _{OSC_BM}	VFB=1.5V,CS=0.3V	20.0	25.0	28.0	kHz
频抖调制频率	F _{jitter}			30		Hz
频抖范围	△F _{OSC}			±6		%
FB检测部分						
FB 开路电压	V _{FB}		4.8	5.1	5.4	V
FB 短路电流	I _{FB_SHORT}		0.17	0.2	0.23	mA
最大占空比	D _{max}		70.0	80.0	90.0	%
进入降频模式阈值电压	V _{FB_PFM_L}	IDMG>330uA		2.3		V
		IDMG<330uA		1.75		V
退出降频模式阈值电压	V _{FB_PFM_H}	IDMG>330uA		2.7		V
		IDMG<330uA		2.0		V
进入间歇模式阈值电压	V _{FB_BM_L}			1.15		V
退出间歇模式阈值电压	V _{FB_BM_H}			1.25		V

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
过载保护阈值电压	Vth_OLP		4.1	4.4	4.7	V
过载保护延迟时间	Td_OLP			60.0		ms
CS电流检测部分						
软启动时间	Tss			6.0		ms
前沿消隐时间	TLEB			400		ns
过流保护阈值	Vth_OCP		0.7	0.75	0.8	V
次级整流短路保护阈值电压	V _{DSP}			1.1		V
次级整流短路保护延迟时间	Td_DSP			7		cycles
CS OTP 保护阈值	V_CSOTP			0.8		V
CS OTP 保护延迟时间	Td_CSOTP			48.0		ms
DMG检测部分						
过压保护阈值电压	Vth_DOVP		2.7	3.0	3.3	V
DMG 过压保护延迟时间	Td_DOVP			7.0		cycles
最大时钟开启等待时间	Thold			5.0		us
斜坡补偿最小占空比	Duty_Slope	Fosc=65kHz		35.0		%
最大开启时间	Ton_max		10.0	12.0	14.0	us
GATE 驱动部分						
输出低电平	V _{OL}				1.0	V
输出高电平	V _{OH}		6.0			V
输出钳位电压	V_clamping	CS=0.3V,FB=3V		12.0		V
输出上升时间	T _r	1.2V~10.8V@CL=1000pF		60.0		ns
输出下降时间	T _f	10.8V~1.2V@CL=1000pF		20.0		ns
过温保护部分						
过温保护温度	T _{SD}		135	150		°C
过温保护回差	T _{HYST}			30		°C

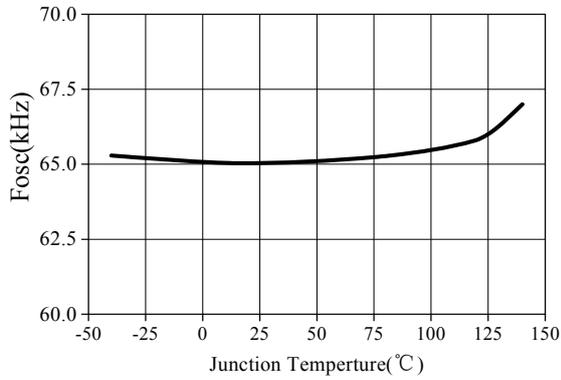
特性曲线



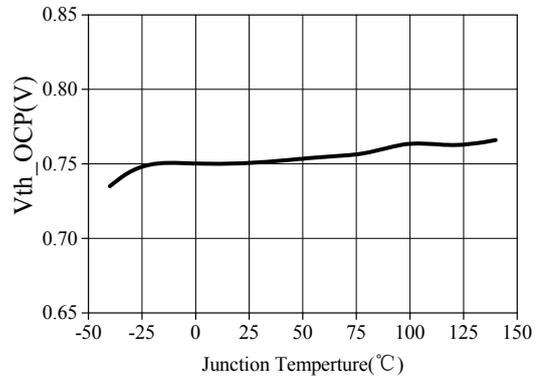
(a) VDD_{ON} vs T_j



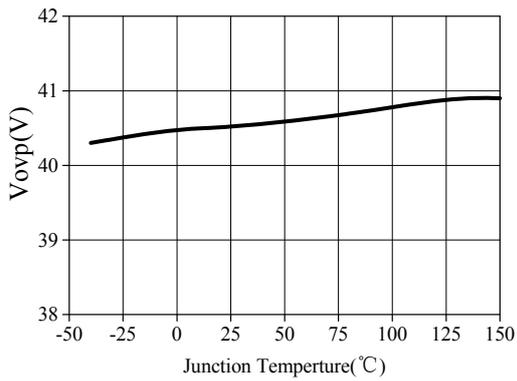
(b) VDD_{OFF} vs T_j



(c) F_{osc} vs T_j



(d) V_{th_OCP} vs T_j



(e) V_{ovp} vs T_j

功能描述

1. 启动

AP8268的启动电流相当低，故VDD电压可快速的被充电到大于UVLO阈值电压VDD_{ON}，因此可使用一个较大的启动电阻用于减小损耗，同时获得较快的启动速度。当VDD电压达到VDD_{ON}，芯片开始工作。启动过程结束后，变压器辅助绕组对VDD电容提供能量。

2. 软启动

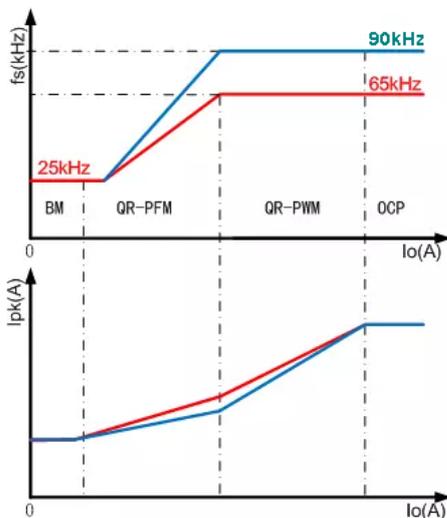
启动阶段，CS脚内部的最大峰值电流电压限制逐步的提高；可以大大减小器件的应力，防止变压器饱和。软启动时间典型值为6ms。

3. 振荡器

AP8268在PWM模式振荡频率固定，当I_{DMG}>330uA时，系统处于高输入电压段，此时工作频率为65kHz，当I_{DMG}<330uA时，系统处于低输入电压段，此时工作频率为90kHz。AP8268通过提高高低输入压时的工作频率，可降低对变压器的要求。根据DMG上偏电阻设置线电压分频点。

4. 降频工作模式

AP8268提供降频工作模式，通过检测FB脚电压，在轻载和空载条件下降低开关频率以提高轻载效率。当FB脚电压小于V_{FB_PFM_L}，芯片进入降频工作模式，开关频率随负载降低而降低，直至最小频率25kHz。



5. 谷底开通 (AP8268A)

AP8268根据开关管波形计算励磁电感与寄生电容振荡周期，在DCM模式下实现精确谷底开通，提高转换效率。

6. 间歇工作模式

极轻载时，AP8268进入间隙工作模式以减小待机功耗。当负载减轻，反馈电压减小；当FB脚电压小于V_{FB_BM_L}（典型1.15V），芯片进入间歇工作模式，功率管关断。当FB脚超过V_{FB_BM_H}时，开关管再次导通。

7. 输出驱动

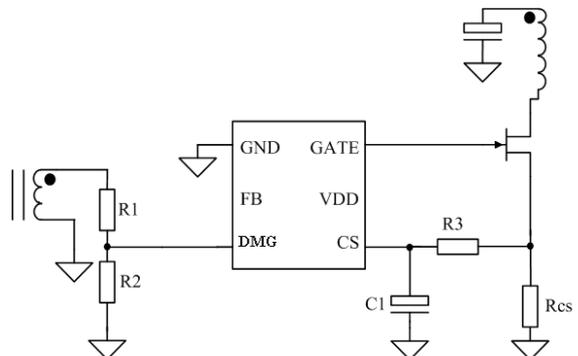
AP8268的输出级采用的是图腾柱结构，用于驱动外部MOSFET的栅极。死区时间防止了电源到地的直接通路，既降低了功耗，同时又保证了高压驱动管不被烧坏。输出驱动的最大电压被内部的齐纳二极管箝位在12V。AP8268经过优化的输出驱动电路，可减小开关损耗同时又有很好的EMI特性。

8. 斜坡补偿

AP8268采用峰值电流控制，内置斜坡补偿功能，通过将电压锯齿信号叠加在采样电压信号上，以改善系统闭环稳定性。

9. 自适应的线电压补偿

AP8268通过DMG引脚上偏电阻检测输入电压，从而产生线补偿电流I_{LC}到CS引脚，其中I_{LC}=K*I_{DMG}，K=0.375为采样DMG引脚电流的比例系数。线补偿电流I_{LC}通过偏置连接在CS引脚与CS检测电阻R_{cs}间的电阻R3产生补偿电压，补偿量的大小由电阻R3的阻值决定。



10. 过压保护

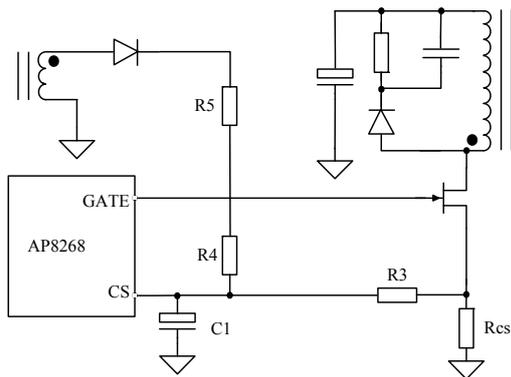
AP8268通过在消磁阶段采样辅助绕组电压，实现精确的过压保护。当采样的DMG平台电压大于3V且持续7个PWM周期，触发输出OVP保护，输出关闭。通过选择合适的DMG下拉电阻R2阻值来设置DMG OVP保护点。

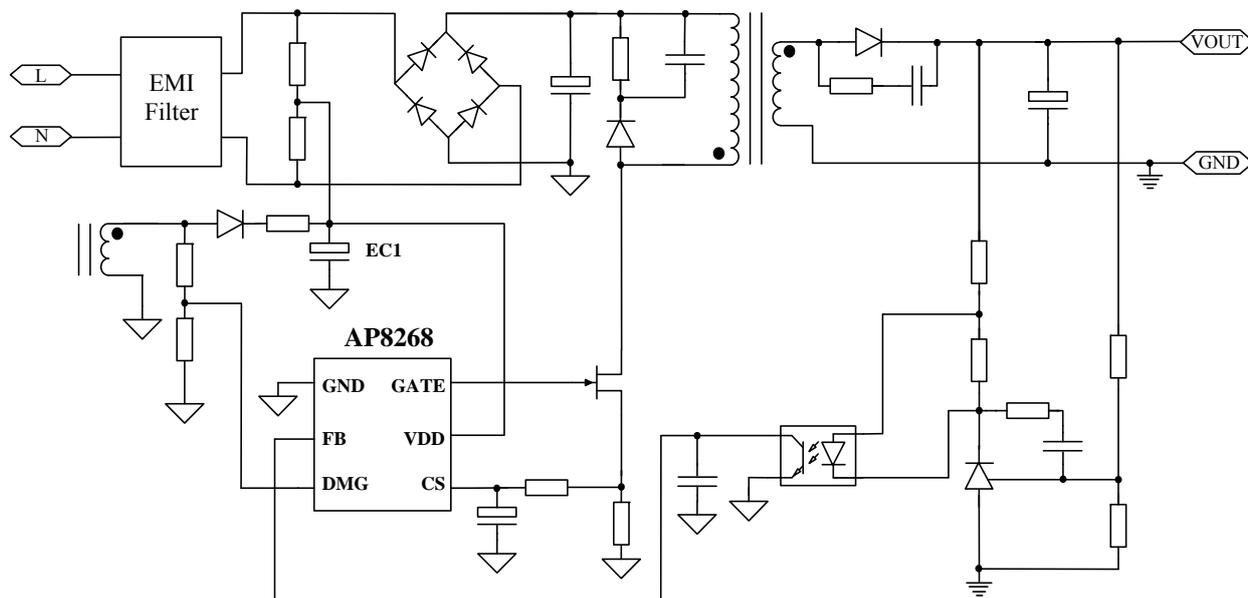
11. 过载保护

负载电流超过预设值时，系统会进入过载保护；在异常情况下，可对系统进行保护。当 V_{FB} 电压超过4.4V，经过固定60ms的延迟时间，开关模式停止。

12. 过温保护

AP8268同时提供片和片外的过温保护。当芯片温度超过 150°C ，芯片进入过温保护状态。同时AP8268可以通过外部NTC电阻检测系统的热点是否超过设定值，当检测到CS电压大于 V_{CSOTP} 持续 T_{s_CSOTP} 则触发保护。



典型应用电路

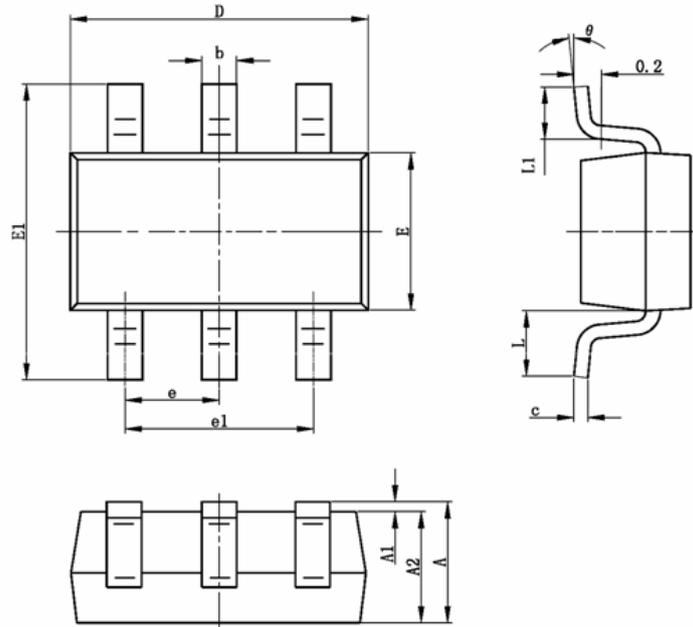
外围参数选择参考

为了获得更佳的 AP8268 系统性能，请务必遵守以下规则：

1. VDD 电容 EC1 应放置在距离 VDD 引脚和 GND 引脚最近的地方。

封装信息

SOT-23-6L 封装外形及尺寸



符号	尺寸	最小(mm)	最大(mm)	符号	尺寸	最小(mm)	最大(mm)
A		1.050	1.250	E1		1.500	1.700
A1		0.000	0.100	E		2.650	2.950
A2		1.050	1.150	e		0.950(BSC)	
b		0.300	0.500	e1		1.800	2.000
c		0.100	0.200	L1		0.300	0.600
D		2.820	3.020	∅		0°	8°

型号	表层丝印	封装
AP8268A	69XXX	SOT-23-6L
AP8268B	68XXX	

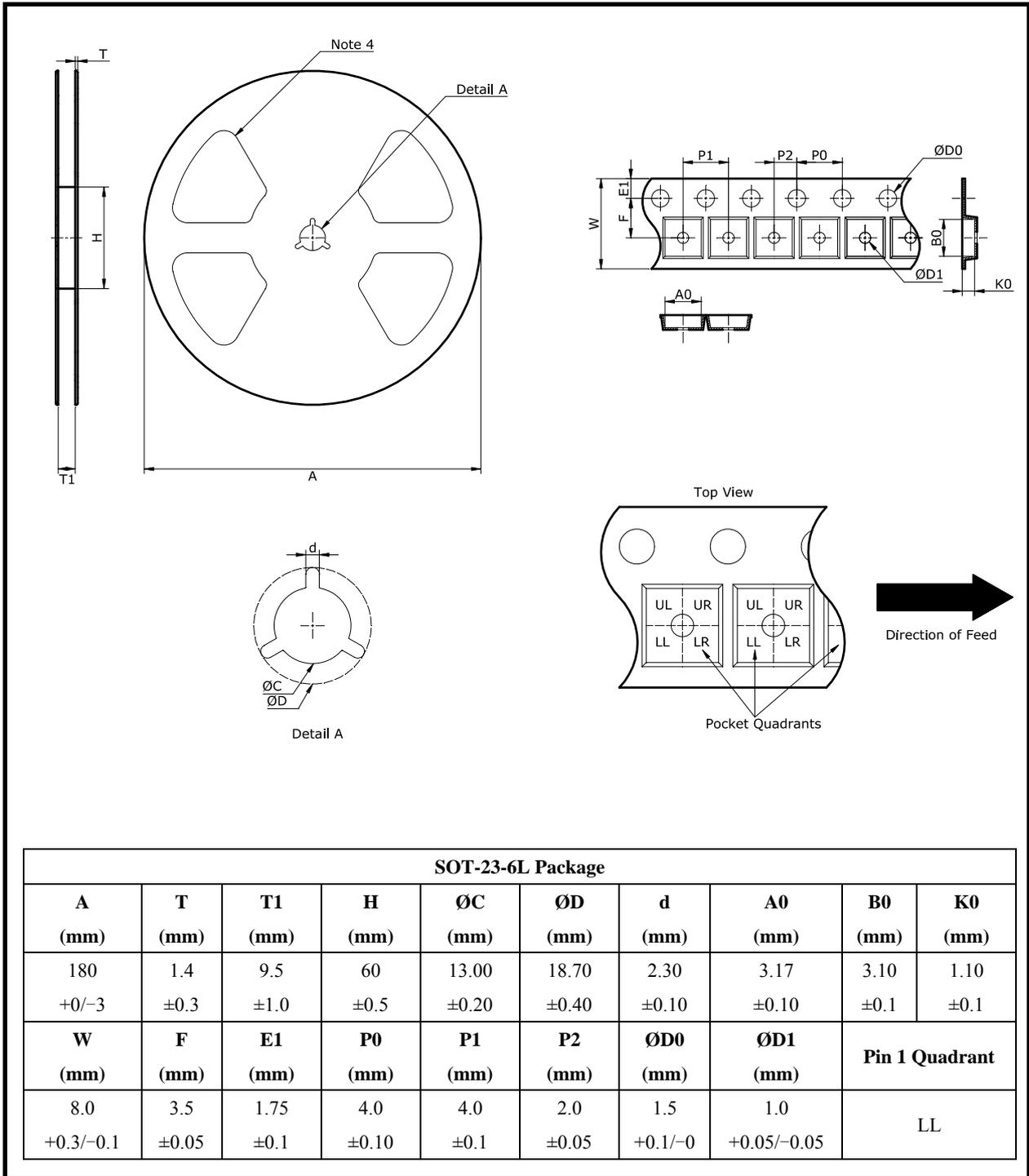
备注: XXX 为内部代码

备注:

1. 此制图可以不经通知进行调整;
2. 器件本体尺寸不含模具飞边;

、

编带及卷轴信息



备注:

1. 此制图可以不经通知进行调整;
2. 所有尺寸是毫米公制的标称值;
3. 此制图并非按严格比例, 且仅供参考。客户可联系芯朋销售代表获得更多细节;
4. 此处举例仅供参考。

重要声明

无锡芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利，恕不另行通知。无锡芯朋微电子股份有限公司对任何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任，无锡芯朋微电子股份有限公司没有为用于特定目的的产品提供使用和应用支持的义务。无锡芯朋微电子股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。